

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЩЕЛИ СВЕРХРЕШЕТОК СВЕРХПРОВОДНИК-ФЕРРОМАГНЕТИК

С.В.Куплевакский, И.И.Фалько¹⁾

*Харьковский государственный университет
310077 Харьков, Украина*

¹⁾ *Харьковский политехнический институт
310002 Харьков, Украина*

Поступила в редакцию 13 января 1992 г.

Получен спектр возбуждений сверхрешеток типа S/F и $S/I(F)$ (S - сверхпроводник, F - ферромагнитный металл, $I(F)$ - ферромагнитный диэлектрик). Показано, что в обоих случаях (для S/F -сверхрешетки требуется выполнение определенных условий) в области энергетической щели существуют узкие блоховские зоны квазичастичных состояний с одной ориентацией спина. Характер блоховских зон $S/I(F)$ -сверхрешетки необычен: их ширина является быстроосциллирующей функцией толщины сверхпроводящего слоя.

В последние годы был создан ряд пространственно-периодических структур с чередующимися слоями из сверхпроводящего и магнитного материалов (в частности, системы с непосредственной проводимостью Mo/Ni ¹, V/Fe ², где Mo , V - низкотемпературные сверхпроводники, Ni , Fe - зонные ферромагнетики и системы $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}/Pr_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$ ³⁻⁵, где $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$ - высокотемпературный сверхпроводник, $Pr_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$ - полупроводник с антиферромагнитным порядком при $T \lesssim 17K$). Почти идеальная периодичность и контролируемая (в известных пределах) чистота образцов делает их привлекательными объектами экспериментальных и теоретических исследований. Тем не менее физические свойства сверхрешеток сверхпроводник - магнетик к настоящему времени изучены недостаточно. Имеющиеся теоретические работы посвящены, главным образом, расчету температуры сверхпроводящего перехода (см., например, ⁶ и цитированную там литературу). Мы же хотим обратить внимание на проблему спектра возбуждений при низких температурах, оставшуюся до сих пор за рамками обсуждения.

В статье рассматриваются два типа чистых систем с ферромагнитными слоями: 1) S/F - сверхрешетка (S - сверхпроводник, F - ферромагнитный несверхпроводящий металл); 2) $S/I(F)$ - сверхрешетка ($I(F)$ - ферромагнитный диэлектрик). Известно, что спектры возбуждений одиночных контактов $S/F/S$ и $S/I(F)/S$ обнаруживают нетривиальные особенности. В частности, при произвольно малой величине спонтанного момента в спектре контакта $S/I(F)/S$ в отсутствие джозефсоновских токов и внешних магнитных полей формируется единственный дискретный уровень, соответствующий поляризованному квазичастичному состоянию вблизи барьера ^{7,8} ²⁾. Появление локализованного состояния связано с подавлением куперовского спаривания на $S/I(F)$ -границах, а его энергия дается формулой ⁸

$$E_{0+}(t) = \Delta_{\infty} [1 - 2T_S(t)], \quad |t| \gg \max\{(\Delta_{\infty}/E_F)^{1/2}, [T_S(1)]^{1/4}\}, \quad (1)$$

где Δ_{∞} - параметр щели в глубине сверхпроводящих берегов, $T_S(t)$ - обменная часть вероятности туннелирования, зависящая от косинуса угла падения на барьер ($T_S(1) \ll 1$). Как показано в работе ¹⁰, в контакте $S/F/S$ существует

²⁾ Имеются экспериментальные указания на существование подобных состояний для структур $Pb/No(OH)_3/Pb$ ⁹ ($No(OH)_3$ - ферромагнитный диэлектрик при $T \lesssim 2,5K$).

аналог состояния (1) при условии $h \gg \Delta_\infty$, $d \ll v_0/h$ (h - энергетический параметр обменного поля, v_0 - скорость Ферми, d - толщина S -слоя, $\hbar = 1$):

$$E_{0+}(t) = \Delta_\infty \left[1 - \frac{h^2 d^2}{2v_0^2 t^2} \right], \quad |t| \gg \max\{(h/E_F)^{1/2}, dh/v_0\}. \quad (2)$$

Казалось бы, в периодических $S/I(F)$ - и S/F -структурах уровни (1) и (2) должны порождать сходные по свойствам блоховские зоны. Мы продемонстрируем, что в действительности это не так.

1. S/F -сверхрешетка. Считаем, что система полностью однородна в направлениях y, z , а ось x перпендикулярна границам слоев. Будем исходить из системы уравнений Боголюбова - де Жена пониженного порядка с кусочно-постоянной аппроксимацией для вещественного потенциала спаривания $\Delta(x)$ (ср. ¹⁰):

$$[-iv_0 t \tau_3 \frac{d}{dx} + \Delta_\infty \tau_1 - (\Delta_\infty \tau_1 \pm h) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Theta(x - nc) \Theta(d + nc - x)] \psi_\pm = E \psi_\pm. \quad (3)$$

Здесь t - косинус угла между направлением движения возбуждения и осью x ; c - период сверхрешетки ($c = a + d$); τ_i - матрицы Паули в пространстве Горькова-Намбу; $\psi_+ = (u_\uparrow, v_\downarrow)$, $\psi_- = (u_\downarrow, v_\uparrow)$ (индексы "+", "-" соответствуют ориентации квазичастичного спина "вверх", "вниз"). Состояниям внутри щели ($0 < E < \Delta_\infty$) соответствуют ограниченные на всей оси x решения (3), удовлетворяющие условиям непрерывности на S/F -границах и условию Блоха $\psi(x + c) = \exp(\pm iqc) \psi(x)$ с вещественным q . Подчеркнем, что различным знакам t в (3) соответствует два типа возбуждений, и эти возбуждения не перемещиваются, поскольку при андреевском отражении на границах слоев не происходит изменения знака x -компоненты импульса. Разрешимость (3) обеспечивается условием

$$\cos(qc) = \cos \left[\frac{(E \pm h)d}{v_0 |t|} \right] \operatorname{ch} \left[\frac{(\Delta_\infty^2 - E^2)^{1/2} a}{v_0 |t|} \right] - \frac{E}{(\Delta_\infty^2 - E^2)^{1/2}} \sin \left[\frac{(E \pm h)d}{v_0 |t|} \right] \operatorname{sh} \left[\frac{(\Delta_\infty^2 - E^2)^{1/2} a}{v_0 |t|} \right]. \quad (4)$$

Соотношение (4) фактически решает модельную задачу о спектре S/F -сверхрешетки. Здесь мы не будем проводить его детальное исследование при всех допустимых значениях параметров. Отметим только, что при $h = 0$ из (4) следует известный результат теории S/N -сверхрешеток (N - нормальный металл) ^{11,12}, а в пределе $a = \infty$ получаем спектр одиночного $S/F/S$ -контакта ¹⁰. В практически наиболее важном случае $h \gg \Delta_\infty$ (напомним, что обычно $h \sim 10^2 - 10^3$ К, $\Delta_\infty \sim 1 - 10$ К) и $d \ll v_0/h$ (при $d \sim v_0/h$ возможно нарушение корреляции фаз соседних сверхпроводящих слоев ^{1,2,10}) в области щели для каждого $|t|$ существует зона блоховских состояний с положительной ориентацией спина (ψ_+), и в пределе $a \gg v_0^2 t^2 / \Delta_\infty h d$, $|t| \gg \max\{(h/E_F)^{1/2}, dh/v_0\}$, их энергия дается простым аналитическим выражением

$$E_{0+}(t; q) = \Delta_\infty \left\{ 1 - \frac{h^2 d^2}{2v_0^2 t^2} \left[1 + 4 \cos(aq) \exp \left(- \frac{hda \Delta_\infty}{v_0^2 t^2} \right) \right] \right\}. \quad (5)$$

2. $S/I(F)$ -сверхрешетка. Считая, что толщина S -слоев значительно больше толщины $I(F)$ -слоев, как и в теории $S/I(F)/S$ -контактов ^{7,8}, для описания потенциала $I(F)$ -слоев используем δ -функционную аппроксимацию

$$\mathcal{H}_1 = (\mp J + V\tau_3) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - na),$$

где J , V - обменная и необменная части соответственно ($J > 0$, $V > 0$). В отличие от предыдущего случая, понижение порядка дифференцирования по x невозможно, и задача сводится к нахождению собственных значений сингулярного оператора

$$\mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1 \equiv - \left(\frac{1}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + E_F t^2 \right) \tau_3 + \Delta_\infty \tau_1 + \mathcal{H}_1 \quad (6)$$

на классе ограниченных на всей оси x функций. Наиболее простой способ решения дает техника запаздывающих функций Грина. Соответствующая (6) функция Грина находится из уравнения Дайсона с помощью преобразования Фурье. Поскольку эта функция может представлять самостоятельный интерес, приведем ее явный вид:

$$\begin{aligned} G_E^\pm(x, x') &= G_E^{(0)}(x, x') + \frac{m}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq g_0(q, E) e^{iq(x-x')} \times \\ &\times \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{2m}{a} (\mp J + V\tau_3) g_n(q, E) \exp(i2\pi n x/a) \times \\ &\times \left[1 + \frac{2m}{a} (\mp J + V\tau_3) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_n(q, E) \right]^{-1}, \end{aligned} \quad (7)$$

$$g_n(q, E) = \left\{ \left[\left(q + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 - 2mE_F t^2 \right] \tau_3 + 2m\Delta_\infty \tau_1 - 2m(E + i0) \right\}^{-1},$$

где $G_E^{(0)}(x, x')$ - функция Грина оператора \mathcal{H}_0 (однородный сверхпроводник) ⁸. Пределами (7) при $\Delta_\infty = 0$ и $a \rightarrow \infty$ являются функции Грина соответственно сверхрешетки в нормальном состоянии ¹³ и контакта $SI/(F)/S$ ⁷. Спектр возбуждений для $0 < E < \Delta_\infty$ определяем из условия

$$\det \left[1 + \frac{2m}{a} (\mp J + V\tau_3) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_n(q, E) \right] = 0. \quad (8)$$

Выполняя суммирование с помощью интегрирования в комплексной плоскости, можно убедиться, что (8) имеет решения только при верхнем знаке перед J . В случае малой прозрачности $I(F)$ -слоев ($v_0, J \ll V$) и $a \gg v_0/\Delta_\infty [T_S(1)]^{1/2}$ ($T_S(t) = v_0^2 J^2 t^2 / V^4$), $|t| \gg \max\{(\Delta_\infty/E_F)^{1/2}, [T_S(1)]^{1/4}\}$ получим

$$\begin{aligned} E_{0+}(t; q) &= \Delta_\infty \left\{ 1 - 2T_S(t) [1 + 4 \cos(ap_0 t) \cos(aq)] \times \right. \\ &\times \left. \exp \left(- \frac{2a[T_S(1)]^{1/2} \Delta_\infty}{v_0} \right) \right\}, \end{aligned} \quad (9)$$

где $p_0 = mv_0$ - импульс Ферми.

Очень необычно (ср. с (5)) присутствие в формуле (9) фактора $\cos(ap_0 t)$, благодаря которому ширина блоховской зоны при заданном $|t|$ становится быстроосциллирующей функцией толщины S -слоев и даже обращается в нуль, если $ap_0 |t| = \pi/2 + \pi N$ (N - целое). Физическая причина осцилляций - интерференция состояний $t > 0$ и $t < 0$ в результате "обычного" отражения

на $SI(F)$ -границах. В принципе, осцилляции должны сохраняться с уменьшением a вплоть до самых малых значений, при которых еще возможна сверхпроводимость сверхрешетки, причем по мере убывания толщины S -слоев, максимальная ширина блоховских зон возрастает. Конечно, экспериментальное наблюдение осцилляций сопряжено с известными трудностями, так как требуемая точность приготовления сверхструктуры имеет порядок постоянной кристаллической решетки. В образцах с большим разбросом параметров слоев должно происходить усреднение косинуса, и плотность состояний будет иметь такой же вид, как и в одиночном $S/I(F)/S$ -контакте.

Наконец, укажем, что эффект осцилляции ширины блоховских зон обязан существовать и в том случае, если моменты $I(F)$ -слоев находятся в парамагнитной фазе, причем теперь число допустимых состояний внутри щели удваивается за счет "связывания" квазичастиц с обеими ориентациями спина (ср. обсуждение одиночного контакта ⁸).

Авторы благодарят А.Н.Омельянуку за полезное обсуждение.

Работа поддерживается Научным Советом по проблеме ВТСП в рамках проекта N90118 Государственной программы "Высокотемпературная сверхпроводимость".

-
1. C.Uher et al., Phys. Rev. B **30**, 453 (1984).
 2. H.K.Wong et al., J. Low Temp. Phys. **63**, 307 (1986).
 3. J.M.Triscone et al., Phys. Rev. Lett. **64**, 804 (1990).
 4. Q.Li et al., Phys.Rev. Lett. **64**, 3086 (1990).
 5. D.H.Lowndes et al., Phys. Rev. Lett. **65**, 1160 (1990).
 6. А.И.Буздин, М.Ю.Куприянов, Письма в ЖЭТФ, **52**, 1089 (1990).
 7. M.J. de Wert and G.V.Arnold, Phys. Rev. Lett. **55**, 1522 (1985). Phys. Rev. B **39**, 11307 (1989).
 8. С.В.Куплевацкий, И.И.Фалько, ФММ **6**, 68 (1991); ФТТ **34**, N1 (1992).
 9. F.Stageberg et al., Phys. Rev. B **32**, 3292 (1985), J. Low Temp. Phys. **60**, 435 (1985).
 10. С.В.Куплевацкий, И.И.Фалько, Письма в ЖЭТФ **52**, 957, (1990).
 11. A.P.van Gelder, Phys. Rev. **181**, 787 (1969).
 12. М.В.Баранов, А.И.Буздин, Л.Н.Булаевский, ЖЭТФ **91**, 1063 (1986).
 13. З.А.Касаманян, ЖЭТФ **61**, 1215 (1971).